SPACE CHARGE EFFECTS IN THE RI BEAM FACTORY ACCELERATOR COMPLEX

Hiroki Okuno Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN 2-1 Hirosawa, Wako-shi, Saitama, 351-0198

Abstract

The accelerator complex for RI beam factory (RIBF) was successfully commissioned at the end of 2006 and started supplying heavy ion beams in 2007. However, the beam intensity now available of uranium beam is far below our goal of 1 pµA (6 x 10¹² #/s). In order to achieve it, upgrade plans are under way, including the construction of a new 28 GHz superconducting ECR ion source. The new ECR will take all the succeeding accelerators and beam transport lines to a space charge dominant regime, especially the front end section and the low energy cyclotron, which should be carefully reconsidered to avoid emittance growth due to space charge forces. Simulation results using the code TRACK and OPAL show that space charge forces largely affect the beam dynamics in all the sections.

RIビームファクトリー加速器系における空間電荷効果

1. はじめに

次世代のRIビーム施設を目指す理研のRIビーム ファクトリー (RIBF)^[1]の加速器複合系部分は、 2006年末に完成しファーストビームを得ることがで き、2007年からRIビーム生成の為の重イオンビーム の供給が行われている^[2]。ビーム強度については、 ビーム診断系改良やフラットトップ共振器の導入等 により日々増強しつつあるが、特にウランビームに 対する強度が目標としている1 puA (6 x 10¹² #/s) を下回っており、抜本的なアップグレードが、必要 であり、ファーストビームが得られた当初から、そ の計画が進行中である^[3]。そのアップグレード計画 は、28 GHz 超伝導ECRイオン源の建設^[4,5,6]、この大 強度イオン源からのビームを加速する新入射器系リ ニアックの建設^[7,8]の2本の柱から成る。この28 GHz 超伝導イオン源から来るウランの大強度ビームは数 100 uAに達すると予想されその後の加速器及びビー ム輸送系を空間電荷効果が支配的な領域に導くこと は確実であり、空間電荷力によるエミッタンスの増 大を極力避けるような設計及び運転が必須となって くる。本稿では、まず、設計製作が進んでいる新入



Fig. 1: A plan of the new injector RILAC II.



Fig. 2: Emittance plot of U35+ at the end of the LEBT in the case of 50% neutralization of the space charge forces.

射系における空間電荷効果について、TRACK^[9]によるシミュレーション結果を基に議論する。次にサイクロトロン中の空間電荷効果については、特に低エネルギーサイクロトロンであるRRC(理研リングサイクロトロン)中での縦方向位相空間における渦巻き運動が懸念されるため、OPAL^[10]によるシミュレーション結果を基に議論する。

2. 新入射器系における空間電荷効果

新入射器系の概略図を図1に示す。これは、 ⁸⁴Kr¹³⁺, ¹³⁶Xe²⁰⁺ and ²³⁸U³⁵⁺,といった質量電荷比がほ ぼ7の粒子を核子当たり0.68 MeV まで加速するよう に設計されている。主な構成物は、超伝導イオン源、 4ロッドRFQ、イオン源からRFQの入口まで、低エ ネルギーのビームを輸送するLEBT、3つの4分の1波 長型の共振器から成るドリフトチューブリニアック (DTL) である。以下、TRACK コードを用いてビー ム軌道をシミュレートした結果をLEBT, RFQ, DTL の順で示す。



Fig. 3: Normalized emittance in the horizontal and vertical direction at the exit of the LEBT is listed versus neutralization factor of the space charge forces.

LEBTはイオンの荷電数を選択する前後で2つの部 分に分かれ選択する前については、イオンの引き出 し領域、ソレノイド磁石そして荷電分析の為の90度 分析電磁石で構成されている。偏向電磁石の曲率半 径は510 mm でエッジアングルは27 度に設定され ており、2重収束になるようになっている。まず、 分析スリットでのU(34+), U(35+), U(36+)の3種のイ オンが 0 mAでは良く分離している事が確認された。 しかしながら、より現実的には、イオン源から引き 出される他のイオンからの空間電荷効果も考慮する 必要がある。そのため、U(35+) とイオン源のサ ポートガスとして使われる酸素イオン (2+, 3+, 4+,







Fig.5: Longitudinal emittance plots at the entrance of the RFQ in the case of 0.0 mA and 0.5mA

	Transmission (%)	Trap efficiency (%)
0.0 mA	68.9	86.7
0.5 mA	50.2	81.1

Table 1: Transmission and trap efficiency of the ion beams from the selection slit to the exit of the RFQ.

5+, 6+) も同時にシミュレートされた。各イオンの 電流値は、U³⁵⁺ 0.5 mA, O²⁺ 1.4 mA, O³⁺ 2.5 mA, O⁴⁺ 2.6 mA, O⁵⁺ 1.9 mA, O⁶⁺ 1.6 mA で、LEBT内から発生 する電子によって空間電荷力が中和されるいわゆる Neutralization Factor (NF) も変えて計算された。計 算の結果Uビームのエミッタンスは、NF が減少す るに従って、たとえば図2 に示すように大きく歪む 事がわかった。図3にNFとエミッタンスの関係を示 す。このNFの実際の値は、残念ながら現段階では 理論的に予測することは出来ないため、このLEBT の実験データを待つしかない。

U35+の分析後、イオンビームは、RFQの入口まで 輸送される。図4には、その構成要素と位置が示さ れている。これらについては、佐藤氏のTRANSPORT 等を用いた検討により設計されている[11]。各要素 の磁場強度はTRACE3D^[12]を用いて、RFQの入口での ビームのTWISSパラメータがRFQの要求するそれと マッチするように決定された。このセクションには ビームバンチャーが設置されこの加速条件での基本 周波数である18.25 MHzでバンチされたビームを作 る。このバンチャーの電圧や位置は、基本周波数の 2倍で運転されるRFQの適切なバケットにトラップさ れる効率を最大にするように最適化される必要があ る。そのため、イオンの価数分析後のLEBTからRFQ 出口までのビーム軌道をTRACKによりシミュレー ションし、0.0 mA の時の 0.5 mAの時で比較した。 RFQのVane構造の為の入力ファイルはDESRFQ^[13]に よって作られたものを用いた。図4に0.5 mAの場合 の計算結果を示す。また表1には、このセクション での通過率とトラップ効率を示した。図5にRFQ入口 での縦方向エミッタンスを示すが、0.5 mAの際にバ ンチの形は大きく歪んでいるがトラップ効率にはあ まり変化がない事がわかった。また通過率が0.0 mA と0.5 mAで20% ほど下がるが、これの原因について



Fig. 6: Beam dynamics of the DTL with short MEBT including a re-buncher.

PSI	RRC	fRC	IRC	SRC
Inj. 2				
1	0.644	0.096	0.031	0.016

Table 2: List of the parameter V. The definition of V is shown in the text.

は、検討中である。

DTLについても軌道計算を行ったが、このモデル は、図6に示すように2つのDQとそれに挟まれたリ バンチャー、DTL内の構造を表わすRFギャップ、ド リフトスペース、2つのTQから成る。図6は、0.5mA の時の結果であるが、0.0 mAの時とほぼ同等であ り、DTLのエネルギー領域まで行ってしまえば空間 電荷効果によるエミッタンスの増大も小さい事を 示唆している。

3. サイクロトロン中での空間電荷効果

サイクロトロン中のバンチの縦方向の運動は、 本来、等時性のため、1週毎のバンチの形はほぼ止 まって見える。しかしながら、ビーム電流が増え るに従って、その空間電荷力により渦巻き運動を 起こすようになる。この現象は大強度陽子施設を有 するスイスのPSI研究所の入射用サイクロトロン (Injector 2)で、1980年代に見いだされ精力的に 研究がなされた^[14]。Pozdeyev^[15]らによれば、この 渦巻き運動の程度Vは、イオンの価数q,電流値I, ハーモニクスh,運動量をp=myRωとあらす諸量を用 いて、

 $V = qI/(\gamma^5 mh\omega^3)$

と表わされる。VをRIBF内の4つのサイクロトロン (RRC, fRC, IRC, SRC)と渦巻き運動が顕著にみら れるPSIのInjector 2 について比較したものを表2 に示す。これより特にRRCがPSIのInjector 2 状況 が似ている事が推察される。現在、PSIのAdelmann らによって開発されたOPALコードを使って、RRCの シミュレーションを実施しており、現段階では全部 で300ターンあるうちの10ターンのみの計算である。 一例として0.50 mA 初期位相±4degの時の結果を図 7に示すが、最初の10ターンであっても渦巻き運動 が顕著に見られることがわかる。今後、最終ターン まで、さまざまな電流値、初期条件のもと、計算を 行い、取り出し効率の劣化を議論するとともに、FT 共振器による補正によってそれが改善できるか等の 議論を実施する予定である。

4. まとめ

現在RIBF加速器系進行中のビーム強度増強計画は、 新たな28GHz超伝導ECRイオン源と新入射器リニアッ クを建設するというものである。本稿では、新入射 器系で生じる空間電荷効果を議論するとともに低エ ネルギーサイクロトロンにおける渦巻き運動も生じ る可能性が大きい事を示した。



Fig.7: Longitudinal emittance plots in the RRC. The number in each graph is the turn number after the injection.

参考文献

- [1] Y. Yano, Nuclear Instruments and Methods in *Physics Research B*, vol. 261 pp. 1009-1013, 2007.
- [2] N. Fukunishi, et al., Proc. Particle Accelerator Conference 2009, in press, May 2009, Vancouver.
- [3] O. Kamigaito, et. al., in this proceedings.
- [4] T. Nakagawa, *et. al.*, High Energy Physics and Nuclear Physics **31** (2007) 133.
- [5] Y. Higurashi, et. al., in this proceedings.
- [6] J. Ohnishi, et. al., in this proceedings.
- [7] O. Kamigaito, *et. al.*, 3rd Ann. Meeting of PASJ and 31th Linac meeting in Japan, Sendai, (2006) 502.
- [8] K. Yamada, et. al., in this proceedings.
- [9] P.N. Ostroumov, V.N. Aseev, and B. Mustapha., Phys. Rev. ST. Accel. Beams 7, 090101 (2004).
- [10] A. Adelmann, et. al., Tech. Rep. PSI-PR-09-05, Paul Sherrer Institut (2009).
- [11] Y. Sato, et. al., in this proceedings.
- [12] K. R. Crandall, Los Alamos Report, No. LA-11054-MS, 1987.
- [13] A.A. Kolomiets, et. al., ITEP report, 2001.
- [14] S. Adam, IEEE Trans. On Nuclear Science 32, 2507 (1985).
- [15] E. Pozdeyev, Thesis, MSU, 2003.